**Cerințe parțial 2**

**Dispozitive electronice**

**Teorie:**

1. TEC-J: structură, funcționare, simbol

2. TEC-J: Caracteristici statice de drenă

3. TEC-J: caracteristica de transfer și transconductanța

4. Polarizarea TEC-J: autopolarizare și polarizare cu divizor rezistiv

5. TEC-MOS cu canal inițial: structură, regimurile de funcționare, simboluri

6. TEC-MOS cu canal indus: structură, polarizarea pe poartă, simboluri

7. TEC-MOS cu canal inițial: caracteristica de transfer, transconductanța

8. TEC-MOS cu canal indus: caracteristica de transfer și transconductanța

9. TEC-MOS cu canal inițial: polarizarea la zero

10. TEC-MOS cu canal indus: polarizare cu divizor de tensiune și cu reacție în drenă

**Probleme:**

O problemă cu

* TEC-J + TEC-MOS cu canal indus, *sau*
* TEC-MOS cu canal inițial + TEC-MOS cu canal indus

**Partial examination 2 requirements**

**Electronic Devices**

**Theory:**

1. JFET: structure, basic operation, symbol

2. JFET: drain characteristic curves

3. JFET transfer characteristic and forward transconductance

4. JFET biasing: self-bias and voltage-divider bias

5. D-MOSFET: structure, operation modes, symbols

6. E-MOSFET: structure, operation, symbol

7. D-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance

8. E-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance

9. D-MOSFET: zero-bias

10. E-MOSFET: drain-feedback bias and voltage-divider bias

**Exercises:**

Only one exercise with

* JFET + E-MOS, *or*
* D-MOS + E-MOS